

**東京大学先端科学技術研究センター 極小デバイス理工学分野
技術補佐員（短時間勤務有期雇用教職員）募集要項**

職名及び人数	技術補佐員 1名
契約期間	2026年7月1日～2027年3月31日
更新の有無	更新はしない。
試用期間	採用された日から14日間
就業場所	東京大学先端科学技術研究センター 極小デバイス理工学分野 岩本研究室 (東京都目黒区駒場4-6-1) 変更の範囲：原則同一部局内
業務内容	酸化半導体の薄膜成長および構造評価 変更の範囲：業務上の必要により配置又は業務を変更することがある。
就業日・就業時間	週1日 1日5時間程度(曜日、時間は応相談) 時間外労働を命じることがある。
休日	土・日、祝日、年末年始(12月29日～1月3日)
休暇	年次有給休暇、特別休暇等
賃金等	時給1320円程度 ※資格、能力、経験等に応じて決定する。 通勤手当(原則55,000円/月まで)、超過勤務手当、期末手当
加入保険	法令の定めにより健康保険(文科省共済)、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入
応募資格	1) 4年制大学学部卒以上 2) 分子線エピタキシー法による酸化半導体の結晶成長の経験を有すること 3) 東京大学の公共性を自覚し、使命感を持って働ける方 4) 協調性があり、チームワークを尊重できる方 5) 主体性があり、業務の改善に意欲的な方 6) 基本的なPC操作(Word, Excel, PowerPoint)ができる方
提出書類	1) 東京大学統一履歴書(以下のURLからダウンロードし作成すること) https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
提出方法	メールにて以下のアドレス宛に送付 宛先 神野 莉衣奈 助教 E-mail: jinno@iis.u-tokyo.ac.jp ※2～3日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせ下さい。
応募締切	2026年5月28日(木)必着 書類選考の上、合格者に対し面接を実施。 但し、適任者が見つかり次第、応募を締切ります。
問い合わせ先	〒153-8904 東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学先端科学技術研究センター 助教 神野 莉衣奈 E-mail: jinno@iis.u-tokyo.ac.jp
募集者名称	国立大学法人東京大学
受動喫煙防止	敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)

措置の状況	
その他	<ul style="list-style-type: none">・ 取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。・ 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性がある。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要がある。